

正誤表

本書中に訂正箇所等がありました。申し訳ございませんでした。お手数をおかけしますが、下記ご参照いただきますようお願い申し上げます。(2021年2月3日)

■第1版第4刷(2016年8月29日発行)、第1版第5刷(2020年4月1日発行)の修正箇所

ページ	場所	修正前	修正後	補足
24	図1-31	コイルの図記号の下部に薄い横線が入っている。	薄い横線を削除する。	
70	上から8行目	一方, FETでは, 自由電子のみが……	一方, FETでは, 正孔または, 自由電子のどちらのみが……	
103	図3-23			
111	一番上の行	回路において, $R_1, R_2 \gg h_{ie}$ と考えると $R_1 // R_2$ を無視して低域遮断周波数……	回路の低域遮断周波数……	
112	上から12~13行目	……を示す。この回路において, $R_1, R_2 \gg h_{ie}$ と考えると $R_1 // R_2$ を無視して低域遮断周波数 f_{C3} を……	……を示す。この回路の低域遮断周波数 f_{C3} を……	
133	上から12~18行目	FET増幅回路においても, 96ページの図3-11に示したようなトランジスタ増幅回路と同様の電流帰還バイアス回路を構成することができる。しかし, FETではゲート電流が流れないため, 電流帰還バイアス回路も自己バイアス回路の一種であると考えることができる。また, 電流帰還バイアス回路は, より安定に動作する一方で, 入力インピーダンスが低くなるためにFETの長所を生かせないことや, 電源の利用率が良くないなどの欠点がある。	FET増幅回路においても, 96ページの図3-11に示したようなトランジスタ増幅回路と同様のバイアス回路を構成することができる。しかし, FETではゲート電流が流れないため, それも自己バイアス回路の一種であると考えることができる。また, そのバイアス回路は, エンハンスメント形用にゲート電圧を正に設定できるが, 入力インピーダンスが低くなるためにFETの長所を生かせないことや, 電源の利用率が良くないなどの欠点がある。	
157	下から6行目	差動増幅回路は, 雑音や温度変化, 電源電圧の変動などの……	差動増幅回路は, 雑音や入力の変動などの……	
160	上から12行目	電源電圧の変動や温度変化による h_{fe} の変動などの影響も……	入力の変動などの影響も……	
227	式(7-8)	振幅条件: $ A_v F$ の実数部 ≥ 1 周波数条件: $ A_v F$ の虚数部 $= 0$	振幅条件: $ A_v F$ の実部 ≥ 1 周波数条件: $ A_v F$ の虚部 $= 0$	
240	下から3行目	$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$	$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C_1}}$	
330	<第5章> 2の解答	電源電圧の変動, 温度変化による h_{fe} の変動, 雑音などに強い。	入力の変動, 雑音などに強い。	